

## 基本信息



姓名：梁骏吾  
 民族：汉族  
 性别：男  
 籍贯：黄陂区  
 出生日期：1933年9月  
 逝世日期：2022年6月23日

当选信息：  
 1997年 中国工程院  
 所属学部：  
 中国工程院 信息与电子工程学部

## 院士简介

梁骏吾，1933年9月18日出生于武汉，男，汉族，湖北省武汉市人。半导体材料专家。中共党员。1955年毕业于武汉大学。1956-1960年在苏联科学院莫斯科巴依可夫冶金研究所攻读副博士学位，1960年获技术科学副博士学位。现任中国科学院半导体所研究员。曾任中国电子学会半导体材料学会分会主任，现任该分会名誉主任。

1960-1970在中科院半导体所任助理研究员。负责国家十二年科技规划中的高纯硅研制，得到电阻率为 $15 \times 10^4 \text{ohm-cm}$ 的硅单晶，是当时国际上最好结果之一，获1964年国家科委颁发的国家科技成果二等奖。研制的硅无坩埚区熔提纯设备获1964年国家科委全国新产品二等奖。1964-1965年负责组建GaAs液相外延研究。1965年首次研制成功国内第一只室温脉冲相干激光器用的砷化镓外延材料。1966-1969年负责156工程中集成电路用硅外延材料任务。解决了连续生长硅高掺杂外延层、SiO<sub>2</sub>介质层、多晶硅层的工艺技术。为我国第一代介质隔离集成电路提供了外延材料。在4K位和16K位DRAM研制中，成功制备大规模集成电路用无位错、无旋涡、低微缺陷、低碳、可控氧含量的高质量直拉硅单晶。该两项研究分别获中科院1979年及1980年重大成果一等奖。20世纪80年代首创了掺氮中子嬗变区熔硅单晶，获1988年中科院科技进步一等奖。完成了硅中杂质以及外延中气体动力学与热力学耦合计算及微机控制光加热外延炉。完成了MOCVD生长 GaAlAs/GaAs 量子阱超晶格材料‘863’任务，突破了我国多年来未能生长低阈值的量子阱激光器材料的局面。近年来从事光伏电池材料和器件工作。

1997年当选为中国工程院院士。

## 主要学历

1948年 - 1951年 武汉市第一中学  
 1951年 - 1955年 武汉大学 物理专业 学士  
 1956年 - 1960年 苏联科学院冶金研究所 冶金专业 副博士

## 主要经历

1960年 - 1969年 中国科学院半导体研究所 副主任、助理研究员  
 1970年 - 1978年 湖北宜昌半导体厂 助理研究员  
 1978年 中国科学院半导体研究所 研究员、博士生导师  
 2011年 哈尔滨工业大学 教授

本资料由中国工程院院士馆提供

